

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 8 月 20 日 (2009.8.20)

【公開番号】特開 2008-103609 (P2008-103609A)

【公開日】平成 20 年 5 月 1 日 (2008.5.1)

【年通号数】公開・登録公報 2008-017

【出願番号】特願 2006-286235 (P2006-286235)

【国際特許分類】

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 29/423 (2006.01)

H 0 1 L 29/49 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

G 0 9 F 9/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 6 1 7 L

H 0 1 L 29/78 6 1 2 B

H 0 1 L 29/78 6 1 7 K

H 0 1 L 29/78 6 1 3 A

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 1 L 29/58 G

H 0 1 L 21/88 R

G 0 9 F 9/30 3 3 8

G 0 9 F 9/00 3 3 8

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 7 月 7 日 (2009.7.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

トップゲート型の薄膜トランジスタと保持容量を有する画像表示装置であって、
ポリシリコン膜と、ゲート絶縁膜と、下層金属膜および上層金属膜が、この順で下層か
ら上層に向かって積層されており、

前記薄膜トランジスタのチャネル、ドレイン、及びソースが前記ポリシリコン膜に形成
されており、

前記薄膜トランジスタのゲート電極は前記下層金属膜と前記上層金属膜を含む積層構造
を有し、

前記保持容量の上部電極は前記下層金属膜であり、前記保持容量の下部電極は前記ポリ
シリコン膜であることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記薄膜トランジスタは、n チャネル伝導型および p チャネル伝導型の何れかであるこ
とを特徴とする画像表示装置。

【請求項 3】

請求項 1 において、

前記下層金属膜は透明電極であることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 4】

請求項 1 において、

前記下層金属膜の膜厚は、前記上層金属膜の膜厚よりも薄いことを特徴とする画像表示装置。

【請求項 5】

請求項 4 において、

前記下層金属膜の膜厚は、20 nm 以上 60 nm 以下であることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 6】

請求項 1 において、

前記ゲート電極の下層金属膜の幅は、当該ゲート電極の上層金属膜の幅と同一であることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 7】

請求項 1 において、

前記ゲート電極の下層金属膜の幅は、当該ゲート電極の上層金属膜の幅より広いことを特徴とする画像表示装置。

【請求項 8】

請求項 1 において、

前記下部電極と前記ドレインおよびソースのイオン濃度は等しいことを特徴とする画像表示装置。

【請求項 9】

請求項 1 において、

前記下部電極と前記ドレインおよび前記ソースのイオンは一つのイオン注入工程によって注入されたものであることを特徴とする画像表示装置。